

御中

デバイス移行のお知らせ Device Migration (DM)

件名: TSPG MRAM MR2A16A Mask revision変更のお知らせ

《お願い》
本変更通知に関してご意見・ご要求のある場合は、作成日より一ヵ月以内に
弊社担当営業までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
尚、ご連絡が無い場合は本変更が承認されたと判断させていただきます。



2007年10月10日

フリースケール・セミコンダクター・ジャパン

TSPG Business Management

該当GPCN番号:

12887

変更内容:

Mask revision 変更に伴い、オーダー可能な製品番号を変更致します。
MR2A16ATS35C→MR2A16AYS35
MR2A16ATS35CR→MR2A16AYS35R

変更理由:

データシートのTable3及び4のスペックを変更致しました。詳細は添付データシートを御参照下さい。

Table3

旧:Maximum magnetic field during write was 15 Oersted.

新:Maximum magnetic field during write is 25 Oersted.

Table4

旧:After power up or if VDD falls below V-WI, a waiting period of 2 microseconds must be observed, and the chip enable pin and write enable pin must remain high (inactive) for 2 microseconds.

新:After power up or if VDD falls below V-WI, a waiting period of 2 milliseconds must be observed, and the chip enable pin and write enable pin must remain high (inactive) for 2 milliseconds.

対象製品:

MR2A16ATS35C、MR2A16ATS35CR

最終受注日・最終出荷日

最終受注日: 2007/11/20

最終出荷日: 2007/12/20

変更品の見分け方:

製品番号にて識別可能です。

その他:

--